

# NPN КРЕМНИЕВЫЙ ЭПИТАКСИАЛЬНО – ПЛАНАРНЫЙ ТРАНЗИСТОР КТ645А,Б

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РАБОТЫ В АППАРАТУРЕ ШИРОКОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

- \* Зарубежный аналог – BC547, BC238
- \* Изготавливается в корпусе **КТ-26 (ТО-92)**.



1 – Коллектор 2 – База 3 – Эмиттер

## ПРЕДЕЛЬНО- ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Параметры		Обозначение	Ед. измер.	Значение
Напряжение коллектор-база	КТ645А	U <sub>кб</sub> max	В	60
	КТ645Б			40
Напряжение коллектор-эмиттер	КТ645А	U <sub>кэ</sub> max	В	50
	КТ645Б			40
Напряжение эмиттер-база	КТ645А	U <sub>эб</sub> max	В	4
	КТ645Б			5
Постоянный ток коллектора		I <sub>к</sub> max	мА	300
Импульсный ток коллектора (t <sub>и</sub> ≤ 10 мс, Q ≥ 5)		I <sub>ки</sub> max	мА	600
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора		P <sub>к</sub> max	мВт	500
Импульсная рассеиваемая мощность коллектора		P <sub>и</sub> max	мВт	1000
Температура перехода		T <sub>п</sub>	°С	150

## ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ( T<sub>окр.ср.</sub>=25°С )

Параметры	Обозначение	Ед. измер	Режимы измерения	Min	Max
Граничное напряжение коллектор - эмиттер	U <sub>кэо</sub> гр.*	В	I <sub>к</sub> = 10мА, I <sub>б</sub> =0	30	
Обратный ток коллектора	I <sub>кбо</sub>	мкА	U <sub>кб</sub> =40 - 60В, I <sub>э</sub> =0		10
Статический коэффициент передачи тока	h <sub>21E</sub>		U <sub>кб</sub> =2В, I <sub>э</sub> =150мА	20	200
			U <sub>кб</sub> =10В, I <sub>э</sub> =2мА	80	
Напряжение насыщения коллектор- эмиттер	U <sub>кэ</sub> (нас)	В	I <sub>к</sub> =150мА, I <sub>б</sub> =15мА		0,5
			I <sub>к</sub> =10мА, I <sub>б</sub> =1мА		0,05
Напряжение насыщения база - эмиттер	U <sub>бэ</sub> (нас)*	В	I <sub>к</sub> =150мА, I <sub>б</sub> =15мА		1,2
Время рассасывания	t <sub>рас</sub>	нс	I <sub>б1</sub> =I <sub>б2</sub> =15мА, I <sub>к</sub> =150мА		50
Емкость коллекторного перехода	C <sub>к</sub>	пФ	U <sub>кб</sub> =10В, f=10МГц		5
Граничная частота коэффициента передачи тока	f <sub>гр</sub> *	МГц	U <sub>кэ</sub> =10В, I <sub>к</sub> =50мА	250	
Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте	τ <sub>к</sub> *	пс	U <sub>кб</sub> =5В, I <sub>э</sub> =5мА, f=5МГц		120

\* Справочные параметры

220108, г. Минск, ул. Корженевского, 16, УП "Завод ТРАНЗИСТОР"

Отдел маркетинга: тел./факс (10-37517) 212-59-32

E-mail: [market@transistor.com.by](mailto:market@transistor.com.by) <http://www.transistor.by>